Секція: Загальна фізика

Назва напряму секції: 4. Фізика твердого тіла. 4.4. Фізичні властивості низьковимірних систем. Фізичні основи цілеспрямованого формування складу та структури матеріалів у компактному та низьковимірних станах, що мають нові корисні властивості

ЗВІТ за 1 етап виконання наукової роботи (науково-технічної розробки) (2019 рік)

- 1. Назва НДР та категорія роботи: Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого кремнію. Фундаментальне дослідження.
- 2. Керівник НДР: Коротченков Олег Олександрович
- 3. Номер державної реєстрації: 0119U100303
- 4. Назва закладу вищої освіти або наукової установи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- 5. Терміни виконання етапу: початок 01.01.2019, закінчення 31.12.2019
- 6. Обсяг коштів, виділених на виконання звітного етапу НДР: 1271.300 тис. грн.
- 7. Короткий зміст запиту (предмет, об'єкт, мета, основні завдання, до 20 рядків) Предмет дослідження: Процеси спрямованої зміни фізичних властивостей наноструктурованих матеріалів з полімерними і напівпровідниковими матрицями та нанонаповнювачами на основі карбону, кремнію та германію.

Об'єкт дослідження: Термічна та механічна стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли, термо-е.р.с. у кремній-германієвих гетероструктурах, процеси дифузії наночастинок у структурі "поруватий кремній-агарозний гель", процеси утворення наноструктурного металу на поверхні нанокарбону.

Мета науково-дослідної роботи: Розробка фізичних засад покращення термічної та механічної стійкості функціональних наноматеріалів на основі нанокарбонових структур, термоелектричних й теплофізичних властивостей гетероструктур Si/Ge та поруватого Si, шляхом модифікування їх структурно-морфологічних, механічних, магнітних властивостей різних форм карбонових наноматеріалів із металевими наночастинками, розміщеними на їх поверхні.

Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети: Комбінацією методів рентгеноструктурного аналізу, електронної мікроскопії, вимірювання електро- та магнітотранспортних характеристик, термо-е.р.с., фототермоакустичної та раманівської спектроскопії, термодесорбції з мас-спектрометричною реєстрацією продуктів визначити фізичні закономірності процесів розподілу та переносу заряду, а також тепла у хімічно функціоналізованих та механічно модифікованих інтерфейсних областях композитних наноматеріалів, з'ясувати вплив структурно-морфологічних особливостей та типу модифікації карбонової компоненти наноструктурованих комрозитів на фізичні закономірності та механізми транспорту носіїв заряду у цих матеріалах.

8. Результати виконання попереднього (за наявності) етапу (до 10 рядків):

9.Опис процесу наукового дослідження за звітним етапом (до 50 рядків):

Заплановані в рамках наукової роботи дослідження виконувалися на наявному в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка обладнанні. Головна ідея досліджень звітного етапу роботи полягала у визначенні фізичних закономірностей та механізмів впливу нанокомпонентів різної природи на фізичні властивості створених на їх основі нанокомпозитних матеріалів.

1

В результаті дослідження зареєстровано та пояснено ефекти руйнування довгих макромолекулярних епоксидних ланцюгів і амінових поперекових зв'язків, а також зв'язування окремих молекулярних груп, що входять до складу цих ланцюгів, і самих амінових зв'язків з активними поверхневими центрами окиснених та неокиснених багатошарових графенових нанопластинок. Запропоновано узагальнену модель процесів, що відбуваються при утворенні наноструктурних форм металу на поверхні карбонового компоненту нанокомпозиту. Запропоновано новий підхід до збільшення термо-е.р.с. композитних структур шляхом розміщення тонких кремнієвих шарів всередині германієвих квантових точок. Показано що параметри термопружного відгуку від зразків гідрогелю агарози з наночастинками залежать від концентрації, просторового положення та поглинальної здатності наночастинок. Встановлено основні закономірності перенесення заряду в гетероструктурах CuS1.8—CdSe.

Галузі застосування результатів роботи включають виготовлення термоелектричних пристроїв на Ge/Si шляхом удосконалення внутрішньої інтерфейсної будови та селективного легування таких композитних структур, нові можливості вивчення та моделювання поведінки біологічних тканин, зокрема, процесів дифузії в біополімерах, пристрої фільтрації спінів та створення магнітних тунельних переходів до підвищеної біоактивності нанокарбонового компоненту, виготовлення нанокомпозитів із поліпшеними механічними, електричними та тепловими властивостями, а також клейові суміші або діелектричні прокладки в електроніці, клейові суміші в автомобілебудуванні, універсальні клейові суміші у побуті.

У цілому структура дослідження першого етапу визначається поєднанням проектування та формування наноструктурованих систем з багатокомпонентними нанонаповнювачами на основі карбону та напівпровідникових складових з визначенням комплексу структурних, механічних тепло- та електрофізичних характеристик створених наноматеріалів.

10. Результати 1 етапу відповідно до технічного завдання:

Номер етапу	Назва етапу згідно з технічним завданням	Заплановані результати етапу	Отримані результати етапу
1	Визначення характеристик вихідних компонентів для виготовлення графен-містких полімерних НСМ на основі епоксидної смоли, відпрацювання технологічних режимів модифікації поверхні графенових нанопластинок, виготовлення пов ерхнево- модифікованих нанопластинок та порівняльні дослідження термодеструкції та статичних	координаційні сполуки, закріплені на поверхні	Отримано зразки: поверхневомодифікованих графенових нанопластинок та графенмістких полімерних нанокомпозитів (неокиснені та окиснені багатошарові графенові нанопластинки, нанопластинки, функціоналізовані діоксидом титану ТіО2 у формі анатазу, нанокомпозити на їх основі з використанням діанової епоксидної смоли ЕД-20); вуглецевих нанотрубок, модифікованих кобальтмісткими комплексами на поверхні нанокарбону; карбонового носія (нанографіт, одностінні та багатостінні вуглецеві нанотрубки), інтеркальованого перехідними металами; вуглецевих нанотрубок, декорованих наночастинками перехідних металів. Визначено концентраційні ефекти впливу

виготовлених прищепленими по поверхні металийстиним комплексами. Буде визначено: 1) концентраційні ефекти впливу графенових нанопластинок на термічну та мехапічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли, за темнературні запежності термо-е.р.с. у кремній-германіевки НСМ. 3) структурно-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компочент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметры процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде створена дійоча модель високочастотного ультразвукового реактора. Витотовини та карбонових на при в кінетичні параметрі структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде створена дійоча модель високочастотного ультразвукового реактора. Витотовими трафеновим нанопластинками заростає лише за пуже малих концентрацій наповнювача (до 10,10%) і заменшується зі зростаєнням вмісту наповнювача у всьому дослідженому інтервапі концентрацій (до 5%). Показан про замішення тонких кремнієвих квантових точок здатне сутгево збільшення кількості прошарків кремнію з одного до двох (відповідно зразих 2-кратної та 3-кратної поступость коефіціент Зеебека, збільшення фонолів на внутрішніх інтерфейсих областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціент мосіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціент мітрую з праметра продска дви праметра продска дви праметра праметра продска дви праметра праметра праметра продска дви праметра праметра продска дви прам	Номер етапу	Назва етапу	Заплановані результати	Отримані результати етапу
параметрів виготовлених НСМ видоплаєтними по поверхні метальпістними комплексами. Вуде визначено: 1) концентраційні ефекти впливу графенових наноплаєтинок на термічну та механічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли, наповненої з неокисидної смоли, наповненої з таков на раменти в на основі епоксидної смоли, наповненої з неокисидної смоли, наповненої з неокисидної смоли, наповненої смоли, наповненої стійкості. Дані, отриматі метотся немонотонні концентраційні залежності термічної стійкості. Дані, отриматі метотся немонотонні концентраційні залежності термічної стійкості. Дані, отриматі метотся немонотонні концентраційні залежності термічної стійкості. Дані, отриматі методикою статичног такаристься немонотонні концентрацій наповненої межа міщності на стискавния епоксидної смоли, наповненої з неокисиненими графеновими графеновими графеновими графеновими наповненої смоли, наповненої з пермати в наповненої смоли, наповненої стиска на примати наповненої смоли, наповненої стійкість на промети на промежа фідчать ди промежа фідчать, до межа міності на примати на промети на примати на промети на примати на промети на примати на		1	етапу	
параметрів виготовлених по поверхії металькіїстними комплексами. Буде визначено: 1) концентраційні ефекти впливу графенових нанопластинок на термічну та мехапічну стійкість неноком позитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е, р.с. у кремпій-германієвих НСМ; 3) структурно- морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової комповиті залежно від параметрів процесу модифікованих карбонової комповиті залежно від параметрів процесу модіторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремпію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремпію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у на кінетичного рівняння коефіціент Зеебека збільшени коефіціент Зеебека збільшени коефіціент засебека збільшени коефіціент засебека таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння більцмана зурахуваннями розсіовання фоновів на внутріштіх інтерфейсих областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єр у на інтерфейсі. Запропонований підкід до збільшения термоелектричних пристрові в інтерфейсі. Запропонований підкід до збільшения термоелектричних пристрові в інтерфейсі. Запропонованний підкід до збільшення коефіціент зеебека в таких зразках кінетичного рівняння термоелектрачних пристрові в інтерфейсі. Запропонованний підкід до збільшення коефіціент зеебека в таких зразках кінетичного рівняння термоелектрачних пристрові в інтерфейсі. Запропонованний підкід до збільшення коефіціент зеебека в таких зразках кінетичного рівняння термоелектрачних пристрові в інтерфейсі. Запропонованний підкід до збільшення коефіціент зеебека в таких				
повержиі металмістинми комплексами. Буде визначено: 1) концентраційні ефекти впливу графенових нанопластинок на термічну та механічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е.р.с. у креміній-германієвих НСМ. Зі структурно-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компочент залежно від параметрів процесу модикації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. 1 наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. 2 на при процесу дифузії на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. 2 на при процесу дифузії на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. 3 на при процесу дифузії на кінетичні параметри процесу дифузії на кінетичні параметри процесу дифузії на кінетичні параметри процесу дібу при при процесу дібу при		параметрів		термічну та механічну стійкість
жомплексами. Буде визначено: 1) концентраційні ефекти впливу графенових нанопластинок на термічну та мехапічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е, р.с. у кремвій-германієвих НСМ, 3) структурно-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастиного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Високосчастотного ультразвукового реактора. Пітромарів кремнію з одного до двох (відповідно зразки 2-кратної та 3-кратної ШК) збільшує коефіціент Зеебека в таких зразках гарно описується в рамаках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсі. Запропокований пітіхід до збільшення коефіціент Зеебека може бути використан для покращення покращени пітіхі до збільшення коефіціент Зеебека покрішент закрам зараду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропокований пітіхі до збільшення коефіціент Зеебека може бути використан для покращення покращени заряду з енергією.			<u> </u>	
визначено: 1) концентраційні ефекти впливу графенових нанопластинок на термічну та механічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е.р.с. у кремній-германієвих НСМ. 3) структурно-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової комповент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремвію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена дійоча модель високочастотного ультразвукового реактора.		HCM	_	
концентраційні ефекти впливу графенових нанопластинок на термічну та мехапічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності терманівли НСК, 3) структурно-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та міриості вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніториягу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремкію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена дійоча модель високочастотного ультразвукового реактора. високом структури та мідраметрів структури та мідраметрів структури та мідраметрів структури та мідраметрів троменную такуж наповнювача у росому інтервалі концентрацій (до 5%). Показан перманіських вайтовких крантовких уремнівах квантовких точок задатк у наповнювача у розміщення точких уремнівах квантовких парк на мідком прадаметри подоковком поможаміщность на стакумним прадаметри от стакумним прадаметри от подоком прадаметри от прадаметри от подоком прадаметри от			5	_
впливу графенових нанопластинок на термічну та механічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е.р.с. у кремній-германієвих НСМ; 3) структурноморфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу моцифікації, параметрів процесу моцифікації, параметрів процесу моцифікації, параметрів процесу мощифікації, параметрів процесу мощифікації, параметрів процесу мощифікації, параметрів процесу мощифікації, параметрів процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена дійоча модель високочастотного ультразвукового реактора. Засека приблизни канточного унаразвукового реактора. Засека приблизна на уракуванням розсіювання фоновів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціенту зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з уракуванням розсіювання фоновів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціенту зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з уракуванням розсіювання фоновів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціенту зеебека паряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціенту зеебека приблизна для покращення коефіціенту зеебека приблизна для покращення керфішіенту зеебека приблизна на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціенту зеебека може бути використан для покращення керфішіенту зеебека може бути використан для покращення термоелектурчим продстання керфішіен зеебека приблизна для покращення керфішіенту зеебека приблизна для покращення термоелектурна запряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення керфішіенту зеебека приблизна для покращення термоелектурна запрядня для покращення для покращення з правимення для покращення з пр			· ·	
нанопластинок на термічну та механічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е.р.с. у кремній-германієвих НСМ; 3) структурноморфологічний стан та стабільність метапічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Нанопластинками, спостерігаються немонотонні концентрацій сківкості. Далі, отримані методикою статичног такамі нетокидної стможня епоксидної смоги наповненой неокисненими трафеновими нанопластинками зоростає лише за дуже малих концентрацій клюсненими трафеновими нанопластинками, статичний модуль Юнга таких нанокомпозитів поступов меншується зі зроставням вмісту наповнювача у всьому досліжженому інтервалі концентрацій (до 5%). Показан що розмішення гонких кремнієвих шарів всередині германісвих квантових точом задагне суттеко збільшити коефіціенту Зесбека. Збільшення коефіціенту Зесбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння больцмана з урахуванням розсіювання фоновів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціен засебека може бути використан для покращення термоелектуричних пристроїв на термоелектурання термоелектурання термоелектурання термоелектурацим продержання термоелектурання термоелектуров на термое				
термічну та механічну стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е.р.с. у кремній германієвих НСМ; 3) структурноморфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Температурно з'ясована кількості прошарків кремнію з одного до двох (відповідно зразки 2-кратної та 3-кратної та 3-кр				
стійкість нанокомпозитів на основі епоксидної смоли; 2) температурні залежності термо-е,р.с. у кремній-германієвих НСМ; 3) структурноморфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена дійоча модель високочастотного ультразвукового реактора. Такра за			термічну та механічну	-
отримані методикою статичног механічного навантаження механічного навантаження стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена дійоча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняня больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт засебека може бути використан для покращення пермоелектричних пристроїв на терфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту за вебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на терфоелектричних пристроїв на терфоелектричних пристроїв на пітерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зе в бека в таких зразках та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зе в бека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на терфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зе в бека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на терфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зе в бека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на терфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зе в бека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на терфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зе в бека може бути використан для покращення термена при за при з			стійкість нанокомпозитів	
залежності термо-е.р.с. у кремній-германісвих НСМ; з) структурио-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікавції, параметрів процесу модифікавції, параметрів процесу модифікавції, параметрів процесу модифікавції, параметрів процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. високочастотного ультразвукового ультразвукового ультразвуковатора на представной такам ультразвуковом ультразвуковам у ременценно				_
кремній-германієвих НСМ; 3) структурио-морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Замення при залежність коефіціснт зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівпяння Больцмана з урахуванням розсіювання фоновів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціснт зеебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціснт зеебека покращення покращення покращення коефіціснт зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівпяння больцмана з урахуванням розсіювання фоновів на внутрішніх інтерфейсіс. Запропонований підхід до збільшення коефіціснт зеебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектричних пристрої на термоелектричних пристрої на термоелектри термоелектри термоелектри термоелектри термоелектри термоелектри тер				отримані методикою статичного
та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Зо структурно та карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Зо структурно телів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Зо структурно телів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Зо структурно телів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. За стискання епоксидної смоли, наповненої неокисненими графеновими нанопластинками графеновими нанопвала дуже малих концентрацій наповнювача (до 0,01%) і зменшується. Разом з именщується зі зростанням вмісту наповнювача (до 0,01%) і зменшується. Разом з именщується зі зростанням вмісту наповнювача (до 0,01%) і зменшується. Разом з пиме, статичий модуль. Юнта таких нановнювача (до 0,01%) і зменшується. Разом з пиме, статичний модуль. Юнта таких нановнювача (до 0,01%) і зменшується. Разом з пиме, статичий модуль. Юнта таких нановнювача (до 0,01%) і зменшується. Разом дименщується зі зростанням вмісту наповнювача у вкеншується. Разом диментрацій наповнювача (до 0,01%) і зменшується. Разом диментрацій наповнювача у вкеншується зі зменшується зі зменшується зі зменшується зі зменшується зі зменшується зі зменшується з пиментрацій наповновани (до 0,01%) і зменшується зі зменшується з пиментрацій наповновачих кантими подвиженням за дуженням ростанням граначних				
морфологічний стан та стабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Зависту наповновіч з ростанням вмісту наповнювача у всьому дослідженому інтервалі концентрацій (до 5%). Показан що розміщення тонких кремніевих квантових точок здатне суттево збільшити коефіціент Зеебека. Збільшення кількості прошарків кремнію з одного до двох (відповідно зразки 2-кратної та 3-кратної ШК) збільшує коефіціент зеебека пиблизно на 40%. Температурна залежність коефіціенту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фонолів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншюю за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіціент зеебека може бути використандля покращення термоелектричних пристроїв на термоелектратичного рівить за трама за трама за трама за трама за достанням за трама за тр				
глабільність металічної та карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелі ва кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнт заебека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнт заяжність коефіцієнт заебека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнт заебека паких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншюю за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт заебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектрої за термо пристрої за терм				l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
карбонової компонент залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншюю за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт зеебека може бути використан для покращення термоелектричних пристрів на термоелектричних пристроїв на тер				
залежно від параметрів процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторинту процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Запечнов поруватого кремієвих шарів всередині германієвих квантових точок здатне суттево збільшити коефіцієнт Зеебека. Збільшення кількості прошарків кремнію з одного до двох (відповідно зразки 2-кратної та 3-кратної ШК) збільшує коефіцієнт Зеебека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіоквання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншюю за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектром прозговання таких нанокомпозить на таких нанокомпозить пристрова на терманіством пристрова на т				l
процесу модифікації, параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектром подів пристрова пристрова пристрова пристрова пристрова пристрова пристрова пристров на термоелектров пристрова п			_	, -
параметрів структури та мірності вихідних для модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнт зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного івняння больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт зеебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на темми на темих на намих на темих на нешера за продага пристрої на темих на нешера за пристрої на темих на темих на темих на темих на темих на				
модифікованих карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Мірності вихідних для модифеньовача у всьому дослідженому інтервалі концентрацій (до 5%). Показані що розміщення тонких кремнієвих квантових точок здатне суттєво збільшити коефіцієнт Зесбека. Збільшення коефіцієнт Зесбека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнту Зесбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіовання фононів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зесбека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на при процесть в заряду з енергією, меншюю за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зесбека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на при продем правення карама в протравня протравня протравня протравня протравня правення протравня				
карбонових НСМ. Буде розроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеєбека може бути використана для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектри на термоелектри на термоелектри на термоелектри на термоелектри на термое на термое на термоелектри на термое на термоелектри на термое на термоелектри на термоелектри на термоелект				таких нанокомпозитів поступово
роэроблено методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсих областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зеебека може бути використандля покращення термоелектричних пристроїв на термоелектри н			модифікованих	зменшується зі зростанням
моніторингу процесу дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Зеебека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту Зеебека може бути використандля покращення термоелектричних пристроїв на термоелектрично пристроїв на термоелектрично пристроїв на термоелектрично пристроїв на термоелектрично пристрої на термоелектри пристрої на термоелектрично пристрої на термоелектрично пристрої на термое			_	
дифузії наночастинок у НСМ на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастного ультранения из заставновати узаки и странения и править продержения и продержения и править продержения и править продержения и править продержения и продержения и править править править продержения и продержения и править править продержения и править продержения и править продержения и править править представления и править представления и править править представления и править править править представления и править править представления и править				
нсм на основі поруватого кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнт зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншюю за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт зеебека може бути використані для покращення термоелектричних пристроїв на т				_
кремнію. Буде з'ясована роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде одного до двох (відповідно зразки 2-кратної та 3-кратної добова доб				
роль структури гелів на кінетичні параметри процесу дифузії наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнту зеєбека може бути використані для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектри на термоелектри на термоелектрої на термоелектри на термоелектри на термоелектри				
кінетичні параметри процесу дифузії кількості прошарків кремнію з одного до двох (відповідно зразки 2-кратної та 3-кратної ШК) збільшує коефіцієнт зеєбека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеєбека Збільшення коефіцієнт заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт зеєбека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на				-
процесу дифузії кількості прошарків кремнію з одного до двох (відповідно зразки 2-кратної та 3-кратної ШК) збільшує коефіцієнт Зеєбека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнтя Зеєбека може бути використань для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектричних пристрої			10 01	•
наночастинок. Буде створена діюча модель високочастотного ультразвукового реактора. Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнтя Зеєбека може бути використана для покращення термоелектричних пристроїв на тер				l - ·
високочастотного ультразвукового реактора. ШК) збільшує коефіцієнт Зеебека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеебека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на				
ультразвукового реактора. Зеебека приблизно на 40%. Температурна залежність коефіцієнту Зеебека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнта Зеебека може бути використано для покращення термоелектричних пристроїв на термое				зразки 2-кратної та 3-кратної
Температурна залежність коефіцієнту Зеєбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнта Зеєбека може бути використано для покращення термоелектричних пристроїв на термоелектри на термоелектри на термоелектри на термоелек				
коефіцієнту Зеєбека в таких зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеєбека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на			ультразвукового реактора.	
зразках гарно описується в рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієн Зеєбека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на				
рамках кінетичного рівняння Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнта Зеєбека може бути використана для покращення термоелектричних пристроїв на				
Больцмана з урахуванням розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеебека може бути використано для покращення термоелектричних пристроїв на				
розсіювання фононів на внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеєбека може бути використано для покращення термоелектричних пристроїв на				-
внутрішніх інтерфейсних областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієнт Зеєбека може бути використано для покращення термоелектричних пристроїв на				,
областях та фільтрацією вільни носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієн Зеєбека може бути використано для покращення термоелектричних пристроїв на				-
носіїв заряду з енергією, меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієн Зеєбека може бути використана для покращення термоелектричних пристроїв на				областях та фільтрацією вільних
меншою за висоту бар'єру на інтерфейсі. Запропонований підхід до збільшення коефіцієн Зеєбека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на				
підхід до збільшення коефіцієнт Зеєбека може бути використан для покращення термоелектричних пристроїв на				
Зеєбека може бути використано для покращення термоелектричних пристроїв на				
для покращення термоелектричних пристроїв на				підхід до збільшення коефіцієнту
термоелектричних пристроїв на				Зеєбека може бути використано
				· ·
լ - Δ/¬լ шпαγωм γπωκουσασυσσ				
Ос/от шлихом удосконаления				Се/51 шляхом удосконалення

Номер етапу	Назва етапу згідно з технічним завданням	Заплановані результати етапу	Отримані результати етапу
			внутрішньої інтерфейсної будови та селективного легування таких композитних структур.
			З'ясовано структурно- морфологічний стан та
			стабільність металічної та карбонової компонент залежно
			від параметрів процесу модифікації, параметрів
			структури та мірності вихідних
			для модифікованих карбонових наноматеріалів. Побудована
			узагальнена модель процесів, що відбуваються при утворенні
			наноструктурних форм металу на поверхні карбонового
			наноматеріалу. Показано, що при хімічній модифікації
			нанотрубок кобальтмісткими комплексами на поверхні
			нанокарбону утворюються функціональні комплекси з
			іонами кобальту. Декорування карбонового наноматеріалу
			наночастинками перехідних металів методом осадження з
			водносольового розчину приводить до утворення
			наночастинок металу (кобальт та нікель) на поверхні частинок
			нанокарбону та частково в міжшаровому просторі.
			Розроблено методику
			моніторингу процесу дифузії наночастинок у наноматеріалі
			на основі поруватого кремнію. Продемонстровано можливість
			використовувати фотоакустичний метод для
			вивчення процесів дифузії в наночастинок у зразках
			гідрогелю агарози. Створено діючу модель високочастотного
			ультразвукового реактора.

11. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (на підставі порівняльних характеристик) (до 20 рядків):

Отримані в роботі результати є оригінальними і мають певні переваги над аналогами. Запропоновано новітній підхід до збільшення термо-е.р.с. шляхом розміщення додаткових надтонких розсіюючих шарів всередині квантових точок. Раніше у структурах-аналогах було

продемонстровано лише зменшення теплопровідності. Вперше запропоновано узагальнену модель процесів, що відбуваються при утворенні нанометалу на поверхні карбонового компоненту. На відміну від аналогів, модель формує цілісне уявлення процесів осадження металу різними широко вживаними методами. Запропоновано новітню методику моніторингу процесу дифузії наночастинок у гелієвих нанокомпозитах. На відміну від аналогів, використаний фотоакустичний відгук має підвищену чутливість до неоднорідності гелю за густиною. Вперше з'ясовано та пояснено процеси руйнування довгих макромолекулярних епоксидних ланцюгів і амінових поперекових зв'язків, а також зв'язування окремих молекулярних груп, що входять до складу цих ланцюгів, і самих амінових зв'язків з активними поверхневими центрами окиснених та неокиснених багатошарових графенових нанопластинок. Продемонстровано застосовність дводіодної моделі для опису вольт-амперних характеристик гетероструктур CuS1.8—CdSe, що є певним просуванням в аналізі фотовольтаїчних пристроїв у порівнянні з описами-аналогами.

12. Результативність виконання звітного етапу науково-дослідної роботи

№ 3/π	Показники	Заплановано (відповідно до проекту), одиниць	Виконано (за резуль- татами НДР), одиниць	Відсоток виконання, %
1.	Публікації виконавців (авторів) за тематикою НДР:			
1.1.	Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних:			
	- Scopus	7	14	перевиконано
	- Web of Science	0	13	100.00
	- Index Copernicus	0	0	100.00
1.2.	Публікації в матеріалах конференцій, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science (або Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук)*	4	4	100.00
1.3.	Статті у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України:	1	1	100.00
	з них: у виданнях з особливим статусом (рекомендовані секціями)**	0	0	100.00
1.4.	Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України (крім тих, що увійшли до п. 1.2.)	14	17	перевиконано
1.5.	Монографії та розділи монографій, опубліковані за рішенням Вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи)	0	0	100.00
1.6.	Монографії та розділи монографій, опубліковані (або підготовлені і подані до друку) в іноземних видавництвах	0	1	перевиконано
1.7.	Підручники, навчальні посібники України	0	2	перевиконано
1.8.	Словники, довідники	0	0	100.00
2.	Підготовка наукових кадрів:			
2.1.	Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР	0	0	

№ з/п	Показники	Заплановано (відповідно до проекту), одиниць	Виконано (за резуль- татами НДР), одиниць	Відсоток виконання, %
2.2.	Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР	1	2	перевиконано
3.	Охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за тематикою НДР:			
3.1.	Отримано патентів України	0	0	100.00
3.2.	Отримано свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір	0	0	100.00
3.3.	Отримано патентів інших держав	0	0	100.00
4.	Участь з оплатою у виконанні НДР (штатних одиниць/осіб):			
4.1.	Студентів	0	0	
4.2.	Молодих учених та аспірантів	1	1	100.00

^{*} Тексти наукових статей, тез доповідей на наукових конференціях та описів отриманих патентів представляти на Web-сторінках організацій-виконавців наукової роботи (науково-технічної розробки).

** Для секцій, які не визначили перелік видань з особливим статусом, оцінюються журнали категорії «Б» згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 148/31600.

13. Перелік виконавців (ПІБ та посада)

- 1. Кузьмич Андрій Григорович, канд. фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), Старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 59.
- 2. Бурбело Роман Михайлович, д-р фіз.-мат. наук, старш. дослідник (старш. наук. співроб.), Провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 71.
- 3. Надточій Андрій Борисович, канд. фіз.-мат. наук, без звання, Старший науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 51.
- 4. Половина Олексій Іванович, канд. фіз.-мат. наук, без звання, Науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 64.
- 5. Горб Алла Миколаївна, канд. фіз.-мат. наук, без звання, Науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 40.
- 6. Чуприна Роман Григорович, без ступеня, без звання, Провідний інженер, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 50.
- 7. Саєнко Галина Володимирівна, канд. фіз.-мат. наук, без звання, Провідний інженер, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 38.
- 8. Майко Олександр Михайлович, без ступеня, без звання, Інженер 1-ї категорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 56.
- 9. Ліщук Павло Олександрович, без ступеня, без звання, Лаборант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 26.
- 10. Боровий Микола Олександрович, д-р фіз.-мат. наук, проф., Завідувач кафедри загальної фізики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 61.
- 11. Оліх Олег Ярославович, д-р фіз.-мат. наук, доц., Доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 44.
- 12. Цареградська Тетяна Леонідівна, канд. фіз.-мат. наук, доц., Доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 50 .
- 13. Овсієнко Ірина Володимирівна, канд. фіз.-мат. наук, доц., Доцент кафедри загальної фізики

фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 52.

- 14. Подолян Артем Олександрович, канд. фіз.-мат. наук, доц., Доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 42.
- 15. Шмід Володимир Ігорович, без ступеня, без звання, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 25.

14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених дисертацій:

Розділи монографій:

1. Matsui L.Y., Vovchenko L.L., Ovsiienko I.V., Tsaregradskaya, T.L.,Saenko G.V. Chapter 23: Theoretical analysis of metal salt crystallization process on the thermoexfoliated and disperse graphite surface . – In "Nanocomposites, Nanostructures and Their Applications. NANO 2018". Springer Proceedings in Physics. –Fesenko O., Yatsenko L. (eds). –Springer, Cham. – 2019. Volume 221. – P. 333–348. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-17759-1_23

Навчально-методичні посібники:

- 1. Physics. Mechanics, Molecular Physics and Thermodynamics: Textbook for foreign students of the preparatory departments. Навчальний посібник / Kozachenko V.V., Kalenyk O.O., Tsaregradska T.L. К.: Publishing and Polygraphic Centre "The University of Kyiv", 2019. 174 р. Рекомендовано до друку вченою радою фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 17.11. 2019 р.) та Науково-методичною Радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5-18/19 від 26.03. 2019 р.) 10,2 др.арк.
- 2. Загальна фізика для хіміків. Збірник задач. Частина 2. Електрика та магнетизм. Навчальний посібник / Боровий М.О., Оліх О.О., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л., Козаченко В.В., Подолян А.О., Ісаєв М.В., Дубик К.В.- Київ-Вінниця: ТОВ "Твори", 2019. 164 с. Рекомендовано до друку вченою радою фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 16.09. 2019 р.) 10,2 др.арк.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science, та у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України:

- 1. Nadtochiy A., Kuryliuk V., Strelchuk V., Korotchenkov O., Li P.-W., Lee S.-W. Enhancing the Seebeck effect in Ge/Si through the combination of interfacial design features. Scientific Reports. 2019. Volume 9. P.16335. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52654-z
- 2. Lee Y., Kim D., Jeong J., Kim J., Shmid V., Korotchenkov O., Vasa P., Bahk Y.-M., Kim D.-S. Enhanced terahertz conductivity in ultra-thin gold film deposited onto (3-mercaptopropyl) trimethoxysilane (MPTMS)-coated Si substrates. Scientific Reports. 2019. Volume 9. P.15025. https://doi.org/10.1038/s41598-019-51085-0
- 3. Savkina R., Smirnov A., Kirilova S., Shmid V., Podolian A., Nadtochiy A., Odarych V., Korotchenkov O. Charge-carrier relaxation in sonochemically fabricated dendronized CaSiO3-SiO2-Si nanoheterostructures. Applied Nanoscience. 2019. Volume 9. Issue 5. P.1047-1056. https://link.springer.com/article/10.1007/s13204-018-0763-3
- 4. Gorelov B.M., Gorb A.M., Nadtochiy A., Starokadomskiy D.L., Kuryliuk V.V., Sigareva N.V., Shulga S.V., Ogenko V.M., Korotchenkov O.O., Polovina O.I. Epoxy filled with bare and oxidized multilayered graphene nanoplatelets: a comparative study of filler loading impact on thermal properties .
- Journal of Material Science. 2019. Volume 54. Issue 12. P.9247–9266. https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-019-03523-7
- 5. Nadtochiy A., Korotchenkov O., Schlosser V. Sonochemical modification of SiGe layers for photovoltaic applications. Physica Status Solidi (a). 2019. Volume 216. Issue 17. P.1900154. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pssa.201900154
- 6. Shmid V., Kuryliuk V., Nadtochiy A., Korotchenkov O., Li P.-W. Improving photoelectric energy conversion by structuring Si surfaces with Ge quantum dots. Proceedings of the 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2019. P.92-96. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8783352
- 7. Shmid V., Podolian A., Nadtochiy A., Korotchenkov O., Romanyuk B., Melnik V., Popov V., Kosulya

- O. Photoelectric properties of SiGe films covered with amorphous- and polycrystalline-silicon layers. Ukrainian Journal of Physics. 2019. Volume 64. Issue 5. P.415. https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/2018573
- 8. Olikh O.Ya. Relationship between the ideality factor and the iron concentration in silicon solar cells. Superlattices and Microstructures. 2019. Volume 136. P. 10639. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749603619316180
- 9. Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Starokadomskiy D.L., Korotchenkov O., Polovina O.I., Sigareva N.V. Impact of multilayered graphene nanoplatelets on 3D-molecular network of an epoxy resin. Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2019). P. 01SSAN07-1 01SSAN07-5. ISBN 978-1-7281-2830-6.
- 10. TsaregradskayaT.L., Kunitskyi Y.A., Kalenyk O.O., Plyushchay I.V., Turkov O.V. Initiation of the explosive crystallization process in amorphous alloys of the Fe-Zr system by pulse laser treatment. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. Volume 11. Issue 2. P.02005-1–02005-4. https://doi.org/10.21272/jnep.11(2).02005
- 11. Tsaregradskaya T.L., Kozachenko V.V., Kuryliuk A.M., Turkov O.V., Saenko G.V. Effect of ultrasonic treatment on phase formation processes in amorphous alloy Fe76 Ni4 Si14 B6. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. Volume11. Issue 3. P.03031-1–03031-4. https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03031
- 12. Tsaregradskaya T.L., Kurilyuk A.M., Saenko G.V., Kurilyuk V.V., Kalenyk O.O., Okonchuk M.V. Effect of thermomechanical and ultrasonic treatment on the properties of amorphous alloys. Proceedings of the 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2019). P.01TFC04-1 P. 01TFC04-4. ISBN 978-1-7281-2830-6.
- 13. Lishchuk P., Isaiev M., Osminkina L., Burbelo R., Nychyporuk T., Timoshenko V. Photoacoustic characterization of nanowire arrays formed by metal-assisted chemical etching of crystalline silicon substrates with different doping level. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2019. Volume 107. P.131–136. https://doi.org/10.1016/j.physe.2018.11.016
- 14. Dubyk K., Pastushenko A., Nychyporuk T., Burbelo R., Isaiev M., Lysenko V. Thermal conductivity of silicon nanomaterials measured using the photoacoustic technique in a piezoelectric configuration. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2019. Volume 126. P.267–273. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2018.12.002
- 15. Lishchuk P., Dubyk K., Kuzmich A., Isaiev M., Naumenko S., Kuryliuk V., Belarouci A., Tkach R., Ostapenko R., Castanet G., Lemoine F., Lysenko V., Lacroix D. Impact of thermal annealing onphotoacoustic response and heat transport in porous silicon based nanostructured materials. AIP Conference Proceedings. 2019. Volume 2170. P.020008. https://doi.org/10.1063/1.5132727
- 16. Ovsiienko I.V., Len T.A., Prokopov O.I., Borovoy M.O., Matzui L.Yu., Syvolozhskyi O.A. The structural studies of phase transitions in the graphite intercalation compounds with iodine chloride and bromine. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. Volume 11. Issue 4. P.04002. https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04002
- 17. Borovyi M.O., Gololobov Yu.P. The near-threshold KL-ionization of Al metal atoms under electron bombardment. Metallophysics and Advanced Technologies. 2019. Volume 41. Issue 11. P.1407-1416.
- 18. Плющай І.В., Цареградська Т.Л., Горкавенко Т.В., Плющай О.І. Першопринципне моделювання електронних та пружних властивостей дефектного кремнію. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2019. Т.17. №3. С.529–542. https://www.imp.kiev.ua/nanosys/media/pdf/2019/3/nano vol17 iss3 p0529p0542 2019.pdf

Захищено дисертації:

- 1. Дубик Катерина Володимирівна. "Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці". Спеціальність 01.04.07. Фізика твердого тіла Науковий керівник: Бурбело Роман Михайлович. 2019 рік. Захист на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, просп. Академіка Глушкова 4, корп. 1, фізичний факультет, ауд. 500.
- 2. Ліщук Павло Олександрович. "Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію". Спеціальність 01.04.07. Фізика твердого

тіла Науковий керівник: Бурбело Роман Михайлович. 2019 рік. Захист на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, просп. Академіка Глушкова 4, корп. 1, фізичний факультет, ауд. 500.

Публікації у матеріалах конференцій:

Публікації у матеріалах конференцій, тези доповідей:

- 1. Shmid V., Podolian A., Nadtochiy A., Korotchenkov O., Romanyuk B., Oberemok O., Sabov T., Dubikovskiy O.Transient surface photovoltage in nano-ZnO films sputtered onto Si substrate / Book of Abstracts of the International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019)". Lviv, Ukraine. 2019. P.588. ISBN 978-966-97587-3-6.
- 2. Nadtochiy A., Korotchenkov O., Schlosser V. Sonochemical modification of SiGe layers for photovoltaic applications / 18th Conference Gettering and Defect Engineering in Semiconductor Technology. Program book. Zeuthen, Germany. 2019. P.15.
- 3. Shmid V., Kuryliuk V., Nadtochiy A., Korotchenkov O., Li P.-W. Improving photoelectric energy conversion by structuring Si surfaces with Ge quantum dots / 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO 2019). Program book. Kyiv, Ukraine. 2019. P.15.
- 4. Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Starokadomskiy D.L., Korotchenkov O., Polovina O.I., Sigareva N.V. Impact of multilayered graphene nanoplatelets on 3D-molecular network of an epoxy resin / 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP-2019). Program book. Odesa, Ukraine. 2019. P.17.
- 5. Sigareva N.V., Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Shulga S.V., Nadtochiy A.B., Kostrzewa M., Ingram A., Polovina O.I. Tailoring physical properties of epoxy by multilayered graphene nanoplatelets / В кн.: "Функціональні матеріали для інноваційної енергетики-ФМІЕ-2019. Збірка тез конференції". Київ, Україна. 2019. Р.88.
- 6. Gorelov B.M., Gorb A.M., Polovina O.I., Sigareva N.V., Mischanchuk O.V., Shulga S.V. Experimental investigation of interface interaction in graphene-epoxy nanocomposites / Book of Abstracts of the Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, Physics and Technology of Surface". Kyiv, Ukraine. 2019. P.74. ISBN 978-966-02-8885-0.
- 7. Gorelov B.M., Gorb A.M., Czapla Z., Wacke S., Nadtochiy A.B., Kuryliuk V.V., Kostrzewa M., Ingram A., Polovina O.I., Sigareva N.V. Epoxy molecular structure alteration in graphene –epoxy nanocomposites: loading effects / Book of Abstracts of the International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019)". Lviv, Ukraine. 2019. P.250. ISBN 978-966-97587-3-6.
- 8. Olikh Ya.M., Tymochko M.D., Olikh O.Ya. Acoustic-induced temperature hysteresis of electrical conductivity in CdZnTe:Cl / В кн.: XVII Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. Збірник тез, за заг. ред. В.В. Прокопіва. Івано-Франківськ, Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, Україна. 2019. С.111.
- 9. Olikh O., Krasko D. Modeling CuS-CdSe solar cell S-shaped I-V characteristics / В кн.: The 2019 U.S. Workshop on the Physics & Chemistry of II-VI Materials, Chicago, USA, 2019. Extended abstract book. P.60-63.
- 10. Olikh Ya.M., Tymochko M.D., Olikh O.Ya. Temperature hysteresis of electrical conductivity caused by ultrasound in CdZnTe:Cl crystals / B κμ.: The 2019 U.S. Workshop on the Physics & Chemistry of II-VI Materials, Chicago, USA, 2019. Extended abstract book. P.64-67.
- 11. Tsaregradskaya T.L., Plyushchay I.V., Kalenyk O.O., Plyushchay A.I., Saenko G.V. Features of phase formation processes in amorphous alloys of Fe-Zr / Book of Abstracts of the International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019)". Lviv, Ukraine. 2019. P.37. ISBN 978-966-97587-3-6.
- 12. Matsui L.Yu., Ovsienko I.V., Vovchenko L.L., Tsaregradskaya T.L., Saenko G.V., Marinin O.D. The kinetic model of nanoscaled metal formation on the surface of different forms of graphite / Book of Abstracts of the International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019)". Lviv, Ukraine. 2019. P.39. ISBN 978-966-97587-3-6.
- 13. Andrusenko D.A., Burbelo R.M., Alekseev O.M., Vasylyuk S.V., Kuzmich A.G. Photoacoustic investigation of dyes and carbon nanoparticles diffusion in agarose hydrogel / Book of Abstracts of

the International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019)". – Lviv, Ukraine. – 2019. – P.192. – ISBN 978-966-97587-3-6.

- 14. Kuzmich A.G., Dubyk K.V., Isaiev M.V., Kuryliuk V.V., Veleschuk V.P., Gnatyuk V.A., Aoki T., Vlasenko Z.K., Levytskyi S.N., Shefer A.V. Melting threshold and thermal conductivity of CdTe under pulsed laser irradiation / Book of Abstracts of the 18th International Conference on Global Research and Education. In Engineering for Sustainable Future inter-Academia. Budapest, Balatonfüred, Hungary. 2019. P.12.
- 15. Syvolozhskyi O.A., Ovsiienko I.V., Matzui L.Yu., Dyachenko A.G., Ischenko O.V., Yakovenko O.S., Len T.A., Borovoy M.O., Teselko P.O. Electro-transport properties of nanocarbon structures modified with nickel and iron / Book of Abstracts of the International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019)". Lviv, Ukraine. 2019. P.146. ISBN 978-966-97587-3-6.
- 16. Yakovenko O.S., Matzui L.Yu., Vovchenko L.L., Lazarenko O.A., Syvolozhskyi O.A., Oliynyk V.V., Zagorodnii V.V., Borovoy M.O., Teselko P.O., Trukhanov A.V., Trukhanov S.V. Effect of magnetic fillers and their orientation on the electromagnetic properties of BaFe12-xGaxO19 (x=0.1-1.2)-epoxy composites within GHz range / Book of Abstracts of the International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019)". Lviv, Ukraine. 2019. P.147. ISBN 978-966-97587-3-6.
- 17. Len T., Ovsiienko I., Syvolozhskyi O., Matzui L., Dyachenko A., Ischenko O., Borovoy M., Tesel'ko P. Metallization of CNTs surface by two-component systems NiFe and CoFe / The 20th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2019. Kyiv, Ukraine. 2019. P.93.
- 15. Рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради від "13" січня 2020р., протокол № 6 щодо завершення етапу.

Керівник роботи	 О.О. Коротченков
Проректор із наукової роботи (Керівник наукової установи)	 О.І. Жилінська